(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2003 年6 月26 日 (26.06.2003)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 03/051904 A1

(51) 国際特許分類7:

C07J 5/00, 75/00

(21) 国際出願番号:

PCT/JP02/11547

(22) 国際出願日:

2002年11月6日(06.11.2002)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ: 特願 2001-386808

2001年12月19日(19.12.2001) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会 社クラレ (KURARAY CO., LTD.) [JP/JP]; 〒710-8622 岡山県 倉敷市 酒津 1 6 2 1 番地 Okayama (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 仲澤 信 (NAKAZAWA,Makoto) [JP/JP]; 〒710-0801 岡山県 倉敷市 酒津 2 0 4 5 番地の 1 株式会社クラレ内 Okayama (JP). 大園 重雄 (OHZONO,Shigeo) [JP/JP]; 〒710-0801 岡山県 倉敷市 酒津 2 0 4 5 番地の 1 株式会社クラレ内 Okayama (JP).

(74) 代理人: 高島 — (TAKASHIMA,Hajime); 〒541-0044 大阪府 大阪市 中央区伏見町四丁目 2番 1 4号 藤村 大和生命ビル Osaka (JP).

(81) 指定国 (国内): CA, CN, HU, IN, MX, US.

(84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

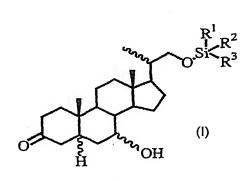
2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: PROCESS FOR PRODUCING PREGNANE DERIVATIVE

OH

(III)

(54) 発明の名称: プレグナン誘導体の製造方法



^tOR⁴

(57) Abstract: A process for producing a 21-hydroxypregnane derivative represented by the general formula (III), (III) characterized by protecting the 7-position hydroxy group of a compound represented by the formula (I) (I) and subsequently eliminating the 21-position protective silyl group. (In the formulae, \mathbb{R}^1 , \mathbb{R}^2 , and \mathbb{R}^3 each independently represents optionally substituted alkyl, alkenyl, alkynyl, aryl, or aralkyl; and \mathbb{R}^4 represents a hydroxy-protecting group.) By the process, a pregnane derivative useful as, e.g., an intermediate for squalamine can be efficiently produced through a small number of steps from easily available materials.

WO 03/051904 A1

(57) 要約:

本発明は、式(I)

$$O = \begin{pmatrix} R^1 \\ R^2 \\ R^3 \end{pmatrix}$$

$$O = \begin{pmatrix} R^1 \\ R^2 \\ R^3 \end{pmatrix}$$

$$O = \begin{pmatrix} R^1 \\ R^2 \\ R^3 \end{pmatrix}$$

$$O = \begin{pmatrix} R^1 \\ R^2 \\ R^3 \end{pmatrix}$$

$$O = \begin{pmatrix} R^1 \\ R^2 \\ R^3 \end{pmatrix}$$

で示される化合物の7位水酸基を保護し、ついで21位シリル基を脱保護することを特徴とする一般式 (III)

で示される21ーヒドロキシプレグナン誘導体の製造方法(上記式中、R¹、R²およびR³はそれぞれ独立して、置換基を有していてもよい、アルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アリール基またはアラルキル基を表し、R⁴は水酸基の保護基を表す。)に関する。本発明によれば、スクアラミンの合成中間体などとして有用なプレグナン誘導体を、入手容易な原料より、短段階で効率よく製造することができる。

明細書

プレグナン誘導体の製造方法

技術分野

本発明は、プレグナン誘導体の製造方法に関する。本発明により製造されるプ 5 レグナン誘導体は、例えば、下式で示されるスクアラミン(squalamin e)の合成中間体として有用である。

10

squalamine

スクアラミンは、グラム陽性菌、グラム陰性菌、真菌などに対する強力な抗菌活性を有するとともに、抗ガン活性を有することが報告され、新たな抗生物質として注目されている化合物である〔ジャーナル・オブ・オーガニック・ケミストリー(J. Org. Chem.)、63巻、3786頁(1998年);ジャーナル・オブ・オーガニック・ケミストリー(J. Org. Chem.)、63巻、8599頁(1998年);WO 98/24800など参照〕。

背景技術

15 従来、スクアラミンはサメの肝臓から抽出されていたが、その抽出効率が 0. $0.01\sim0.002$ w t %と極めて低いため、化学的合成方法の検討が行われてきた。スクアラミンの化学的合成方法としては、1) 3β - アセトキシー5 - コレン酸を出発原料とする方法 [テトラヘドロン・レターズ (Tetrahedron Lett.)、35巻、8103頁(1994年)参照〕、2) 3β - ヒ20 ドロキシー5 - コレン酸を出発原料とする方法 [ジャーナル・オブ・オーガニック・ケミストリー(J. Org. Chem.)、60巻、5121頁(1995年):WO 94/19366参照〕、3) 21 - ヒドロキシー20 - メチルプ

レグナー4ーエンー3ーオンを出発原料とする方法 [WO 98/24800参照]、4)スティグマステロールを出発原料とする方法 [ジャーナル・オブ・オーガニック・ケミストリー (J. Org. Chem.)、63巻、3786頁 (1998年);ジャーナル・オブ・オーガニック・ケミストリー (J. Org. Chem.)、63巻、8599頁 (1998年);WO 98/24800参照]が知られている。

5

10

15

20

25

上記1)、2) および3)の方法で出発原料として用いる3 β -アセトキシー5-コレン酸、3 β -ヒドロキシー5-コレン酸、21-ヒドロキシー20-メチルプレグナー4-エンー3-オンはいずれも高価である。また、上記1)の方法ではスクアラミンを得るまでに17工程を要し、2)の方法では19工程、3)の方法では15工程を要し、反応操作がいずれも煩雑である。したがって、これらの方法はスクアラミンの工業的に有利な製造方法とは言い難い。

一方、上記4)の方法は、出発原料として用いるスティグマステロールを安価に入手可能であるが、スクアラミンの合成までには20工程を要する。また、3位水酸基を選択的に酸化する工程で使用する炭酸銀が高価であること、低温下でのオゾン酸化工程を経由するので特殊な反応設備が必要なこと、などの問題点を有していることから、この方法も必ずしも工業的に有利な方法とはいえない。

しかして、本発明の目的は、スクアラミンの合成中間体などとして有用なプレグナン誘導体を、入手容易な原料より、短段階で効率よく製造し得る方法を提供することにある。

発明の開示

本発明者らは、上記の目的を達成するため、(5α , 7α , 20S) -7, 2 $1-ジェドロキシー20-メチルプレグナー3-オンの21位水酸基を保護した 誘導体、例えば(<math>5\alpha$, 7α , 20S) -7-ヒドロキシー20-メチルプレグナー3-オンー21-オール (<math>1, 1-ジメチルエチル)ジメチルシリル エーテル [バイオオルガニック&メディシナル・ケミストリー(Bioorg. Med. Chem.)、8巻、2059 頁(2000年)参照〕から、例えば上記

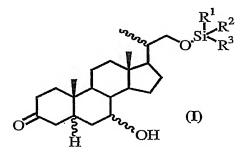
方法 4)における合成中間体であり、スティグマステロールから 7 工程で合成される $(5\alpha, 7\alpha, 20S) - 20 - ホルミル - 3 - (スピロ - 2' - (1', 3' - ジオキソラン)) - プレグナン - 7 - オール ベンゾエートを、高価な反応剤を用いることなく、 3 工程で収率よく製造できることを見出した。$

10 工業的に容易に実施可能な再結晶操作、例えば溶媒存在下、粗生成物を加熱させ 溶媒に溶解後冷却することにより溶媒中から目的物を析出させる再結晶法ないし は溶媒中で粗生成物を懸濁洗浄させ夾雑物を溶媒中に溶解させて精製する懸濁洗 浄法により精製できることを見出し、本発明を完成した。

すなわち、本発明は、

15 ① 式(I)

20



(式中、R¹、R²およびR³はそれぞれ独立して置換基を有していてもよいアルキル基、置換基を有していてもよいアルケニル基、置換基を有していてもよいアルケニル基、置換基を有していてもよいアリール基または置換基を有していてもよいアラルキル基を表す。)で示される21ーシリルオキシプレグナン誘導体(以下、21ーシリルオキシプレグナン誘導体(I)または化合物(I)と略称する)に、塩基の存在下で、水酸基を保護することを特徴とする式(II)

$$O_{\text{H}}^{\text{R}^{1}} \text{CP}^{2}$$

$$O_{\text{H}}^{\text{R}^{1}} \text{CP}^{2$$

(式中、 R^1 、 R^2 および R^3 は前記と同義であり、 R^4 は水酸基の保護基を表す。) で示されるプレグナン誘導体(以下、プレグナン誘導体(II)と略称する)の製造方法、

5 ② プレグナン誘導体 (II) の21位シリルオキシ基のシリル基を脱保護する ことを特徴とする一般式 (III)

(式中、R⁴は前記と同義である。)で示される21-ヒドロキシプレグナン誘導体(以下、21-ヒドロキシプレグナン誘導体(III)と略称する)の製造 方法、

③ 式(IV)

(式中、R41は水素原子またはベンゾイル基を表す。) で示される 2·1-

(((1,1-ジメチルエチル)ジメチルシリル)オキシ)-20-メチルプレグナン誘導体(以下、21-シリル-20-メチルプレグナン誘導体(IV)と略称する)の精製法であって、該21-シリル-20-メチルプレグナン誘導体(IV)を結晶化させることを特徴とする方法、および

5 ④ 式(II-1)

10

15

20

で示される化合物(以下、化合物(II-1)と略称する)、すなわち(5α , 7α , 20S)-21-(((1, 1-ジメチルエチル)ジメチルシリル)オキシ)-20-メチルプレグナ-3-オン-7-オール ベンゾエートを提供することにより達成される。

発明の詳細な説明

R¹、R²およびR³が表すアルキル基としては、炭素数1~6の直鎖状または分枝鎖状のアルキル基が好ましく、例えばメチル基、エチル基、nープロピル基、イソプロピル基、nーブチル基、1ーメチルプロピル基、2ーメチルプロピル基、1,1ージメチルエチル基(tertーブチル基)、nーペンチル基、1ーメチルブチル基、1,1ージメチルプロピル基、1,2ージメチルプロピル基、2,2ージメチルプロピル基、1,2ージメチルプロピル基、2,2ージメチルプロピル基、1ーエチルプロピル基、nーへキシル基などが挙げられる。なかでも炭素数1~4のアルキル基、特にメチル基、1,1ージメチルエチル基が好ましい。これらのアルキル基は置換基を有していてもよく、かかる置換基としては、例えば水酸基;フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ョウ素原子などのハロゲン原子;メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基などのアルコキシル基;フェノキシ基などのアリールオキシ基;ベンジルオキシ基など

のアラルキルオキシ基などが挙げられる。

R¹、R²およびR³が表すアルケニル基としては、炭素数3~6の直鎖状また は分枝鎖状のアルケニル基が好ましく、例えば2-プロペニル基、2-ブテニル 基、3-ブテニル基、1-メチル-2-プロペニル基、2-メチル-2-プロペ ニル基、2ーペンテニル基、3ーペンテニル基、4ーペンテニル基、1ーメチル 5 -2-ブテニル基、1-メチル-3-ブテニル基、2-メチル-2-ブテニル基、 2-メチルー3-ブテニル基、2-メチリデンブチル基、3-メチルー2-ブテ ニル基、3-メチル-3-ブテニル基、1-エチル-2-プロペニル基、1-へ キセニル基などが挙げられる。また、R1、R2およびR3が表すアルキニル基と しては、炭素数3~6の直鎖状または分枝鎖状のアルキニル基が好ましく、例え 10 ば2-プロピニル基、2-ブチニル基、3-ブチニル基、2-ペンチニル基、3 ーペンチニル基、4ーペンチニル基、3ーメチルー2ープロピニル基、2ーエチ ニルプロピル基、2ーヘキシニル基などが挙げられる。これらのアルケニル基お よびアルキニル基は置換基を有していてもよく、かかる置換基としては、例えば 15 水酸基:フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子などのハロゲン原子:メ トキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基などのアルコキシル基:フェ ノキシ基などのアリールオキシ基;ベンジルオキシ基などのアラルキルオキシ基 などが挙げられる。

R¹、R²およびR³が表すアリール基としては、炭素数6~12のアリール基 が好ましく、例えばフェニル基、2ーメチルフェニル基、3ーメチルフェニル基、 4ーメチルフェニル基、2,3ージメチルフェニル基、2,4ージメチルフェニ ル基、2,5ージメチルフェニル基、2,6ージメチルフェニル基、4ープロピ ルフェニル基、4ーブチルフェニル基、ナフチル基、2,3ージメチルナフチル 基、2,4ージメチルナフチル基などが挙げられる。これらのアリール基は置換 25 基を有していてもよく、かかる置換基としては、例えば水酸基;フッ素原子、塩 素原子、臭素原子、ヨウ素原子などのハロゲン原子;メチル基、エチル基、プロ ピル基、イソプロピル基、ブチル基、イソブチル基、secーブチル基、ter

tーブチル基などのアルキル基;メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基などのアルコキシル基;フェニル基などのアリール基;ベンジルオキシ基などのアラルキルオキシ基などが挙げられる。

R¹、R²およびR³が表すアラルキル基としては、炭素数7~13のアラルキル基が好ましく、例えばベンジル基、1ーフェニルエチル基、ナフチルメチル基などが挙げられる。これらのアラルキル基は置換基を有していてもよく、かかる置換基としては、例えば水酸基;フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子などのハロゲン原子;メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、イソブチル基、secーブチル基、tertーブチル基などのアルキル基;メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基などのアルコキシル基;フェニル基などのアリール基;ベンジルオキシ基などのアラルキルオキシ基などが挙げられる。

5

10

15

20

25

 R^{1} 、 R^{2} および R^{3} が表す基としては、炭素数 $1\sim 6$ の直鎖状または分枝鎖状のアルキル基が好ましく、なかでも炭素数 $1\sim 4$ のアルキル基、特にメチル基、 1, $1-\tilde{\nu}$ メチルエチル基が好ましい。

上記一般式中、R⁴が表す水酸基の保護基としては、水酸基の保護基として作用する限りどのような保護基でもよく、例えばtertーブチル基、tertーアミル基などのアルキル基;ベンジル基、oーメチルベンジル基、mーメチルベンジル基、pーメチルベンジル基、pーメトキシベンジル基、pーメテルベンジル基、がフェニルメチル基、ドリフェニルメチル基などのアラルキル基;アセチル基、クロロアセチル基、ジクロロアセチル基、トリクロロアセチル基、トリフルオロアセチル基、メトキシアセチル基、トリフェニルメトキシアセチル基、フェノキシアセチル基、pークロロフェノキシアセチル基、フェニルアセチル基、ジフェニルアセチル基、プロピオニル基、ブチリル基、バレリル基、4ーペンテノイル基、ピバロイル基、クロトノイル基、ベンゾイル基、oーメチルベンゾイル基、mーメチルベンゾイル基、pーメチルベンゾイル基、2、3ージメチルベンゾイル基、2、5ー

ジメチルベンゾイル基、2,6-ジメチルベンゾイル基、2,4,6-トリメチ ルベンゾイル基、p-フェニルベンゾイル基などのアシル基;メトキシカルボニ ル基、9-フルオレニルメトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基、2,2, 2ートリクロロエトキシカルボニル基、1、1ージメチルー2、2、2ートリク ロロエトキシカルボニル基、2-(トリメチルシリル)エトキシカルボニル基な 5 どのアルコキシカルボニル基:ビニルオキシカルボニル基、アリルオキシカルボ ニル基などのアルケニルオキシカルボニル基:フェノキシカルボニル基、p-ニ トロフェノキシカルボニル基などのアリールオキシカルボニル基;ベンジルオキ シカルボニル基、p-メトキシベンジルオキシカルボニル基、3,4-ジメトキ シベンジルオキシカルボニル基、oーニトロベンジルオキシカルボニル基、pー 10 ニトロベンジルオキシカルボニル基、2-(4-ニトロフェニル)エトキシカル ボニル基、2-(2,4-ジニトロフェニル)エトキシカルボニル基などのアラ ルキルオキシカルボニル基;メトキシメチル基、ベンジルオキシメチル基、p-メトキシベンジルオキシメチル基、pーニトロベンジルメトキシメチル基、oー ニトロベンジルメトキシメチル基、 (4-メトキシフェノキシ) メチル基、 t e 15 r t ーブトキシメチル基、2 ーメトキシエトキシメチル基、2 ー (トリメチルシ リル)エトキシメチル基などのアルコキシアルキル基;トリメチルシリル基、エ チルジメチルシリル基、イソプロピルジメチルシリル基、tert-ブチルジメ チルシリル基、トリエチルシリル基、tert-ブチルジフェニルシリル基、ト リフェニルシリル基などの三置換シリル基などが挙げられる。なかでもアシル基、 20 特にベンゾイル基が好ましい。

以下、各工程について説明する。

工程1:化合物(I)の7位水酸基を保護してプレグナン誘導体(II)を得る工程

25 化合物(I)の7位の水酸基の保護は、水酸基を保護するに際して通常行われる方法と同様の方法で行うことができる。

例えば、水酸基の保護基として、前記したアルキル基またはアラルキル基を用

いる場合は、tertーブチルクロリド、tertーアミルクロリドなどのアルキルハライド;ベンジルクロリド、ベンジルブロミド、oーメチルベンジルクロリド、mーメチルベンジルクロリド、pーメチルベンジルクロリド、pーニトロベンジルクロリド、pーメトキシベンジルクロリド、pーフェニルベンジルクロリド、pーフェニルメジルクロリド、ジフェニルメチルクロリド、トリフェニルメチルクロリドなどのアラルキルハライドを、水素化リチウム、水素化ナトリウム、水素化カリウム、水素化カルシウムなどの金属水素化物;リチウム、ナトリウム、カリウムなどのアルカリ金属;マグネシウム、カルシウムなどのアルカリ土類金属;炭酸ナトリウム、炭酸カリウムなどの炭酸塩;炭酸水素ナトリウム、炭酸水素カリウムなどの炭酸水素塩などの塩基の存在下に、化合物(I)と反応させることにより行うことができる。アルキルハライドまたはアラルキルハライドの使用量は、化合物(I)1モルに対して1モル以上が好ましく、1~10モルの範囲がより好ましい。また、塩基の使用量は、アルキルハライドまたはアラルキルハライド1モルに対して1モル以上が好ましく、1~10モルの範囲がより好ましい。

5

10

水酸基の保護基として、前記じたアシル基を用いる場合は、アセチルクロリド、 15 アセチルブロミド、クロロアセチルクロリド、ジクロロアセチルクロリド、トリ クロロアセチルクロリド、トリフルオロアセチルクロリド、メトキシアセチルク ロリド、トリフェニルメトキシアセチルクロリド、トリフェニルメトキシアセチ ルブロミド、フェノキシアセチルクロリド、pークロロフェノキシアセチルクロ リド、フェニルアセチルクロリド、フェニルアセチルブロミド、ジフェニルアセ . 20 チルクロリド、プロピオニルクロリド、ブチリルクロリド、バレリルクロリド、 4-ペンテノイルクロリド、ピバロイルクロリド、クロトノイルクロリド、ベン ゾイルクロリド、ベンゾイルブロミド、oーメチルベンゾイルクロリド、mーメ チルベンゾイルクロリド、p-メチルベンゾイルクロリド、2、3-ジメチルベ ンゾイルクロリド、2,4-ジメチルベンゾイルクロリド、2,5-ジメチルベ 25 ンゾイルクロリド、2,6-ジメチルベンゾイルクロリド、2,4,6-トリメ チルベンゾイルクロリド、p-フェニルベンゾイルクロリドなどの酸ハロゲン化

物:無水酢酸、無水クロロ酢酸、無水ジクロロ酢酸、無水トリクロロ酢酸、無水 トリフルオロ酢酸、無水メトキシ酢酸、無水トリフェニルメトキシ酢酸、無水フ エノキシ酢酸、無水pークロロフェノキシ酢酸、無水フェニル酢酸、無水ジフェ ニル酢酸、無水4ーペンテン酸、無水ピバリン酸、無水クロトン酸、無水安息香 5 酸、無水p-フェニル安息香酸などの酸無水物を、水素化リチウム、水素化ナト リウム、水素化カリウム、水素化カルシウムなどの金属水素化物;リチウム、ナ トリウム、カリウムなどのアルカリ金属;マグネシウム、カルシウムなどのアル カリ土類金属;炭酸ナトリウム、炭酸カリウムなどの炭酸塩;炭酸水素ナトリウ ム、炭酸水素カリウムなどの炭酸水素塩;トリメチルアミン、トリエチルアミン、 10 ジイソプロピルエチルアミン、ピリジン、N, N-ジメチルアミノピリジン、N, N-ジメチルアニリン、N, N-ジエチルアニリン、イミダゾールなどのアミン などの塩基の存在下に、化合物(I)と反応させることにより行うことができる。 酸ハロゲン化物または酸無水物の使用量は、化合物(Ⅰ)1モルに対して1モル 以上が好ましく、1~10モルの範囲がより好ましい。また、塩基の使用量は、 酸ハロゲン化物または酸無水物1モルに対して0.1モル以上が好ましく、1~ 15 10 モルの範囲がより好ましい。さらに、2種類以上の塩基を共存させてもよく、 2種類以上の塩基を共存させる場合の塩基の使用量は、酸ハロゲン化物または酸 無水物1モルに対して少なくとも一つの塩基が0.1モル以上であることが好ま しく、一つの塩基が少なくとも0.1~10モルの範囲であることがより好まし 20 い。

水酸基の保護基として、前記したアルコキシカルボニル基、アルケニルオキシカルボニル基、アリールオキシカルボニル基、アラルキルオキシカルボニル基を用いる場合、反応は、クロロギ酸メチル、クロロギ酸エチル、クロロギ酸2,2,2ートリクロロエチル、クロロギ酸9ーフルオレニルメチル、クロロギ酸1,1ージメチルー2,2,2ートリクロロエチル、クロロギ酸2ー(トリメチルシリル)エチルなどのアルコキシカルボニルハライド;クロロギ酸ビニル、クロロギ酸アリルなどのアルケニルオキシカルボニルハライド;クロロギ酸フェニル、クロロギ酸アリルなどのアルケニルオキシカルボニルハライド;クロロギ酸フェニル、ク

ロロギ酸p-ニトロフェニルなどのアリールオキシカルボニルハライド;クロロ ギ酸ベンジル、クロロギ酸 p ーメトキシベンジル、クロロギ酸 3, 4 ージメトキ シベンジル、クロロギ酸oーニトロベンジル、クロロギ酸pーニトロベンジル、 クロロギ酸2-(4-ニドロフェニル)エチル、クロロギ酸2-(2,4-ジニ トロフェニル)エチルなどのアラルキルオキシカルボニルハライドを、炭酸ナト 5 リウム、炭酸カリウムなどの炭酸塩;炭酸水素ナトリウム、炭酸水素カリウムな どの炭酸水素塩;トリメチルアミン、トリエチルアミン、ジイソプロピルエチル アミン、ピリジン、N,Nージメチルアミノピリジン、N,N-ジメチルアニリ ン、N, Nージエチルアニリン、イミダゾールなどのアミンなどの塩基の存在下 に、化合物(I)と反応させることにより行うことができる。アルコキシカルボ 10 ニルハライド、アルケニルオキシカルボニルハライド、アリールオキシカルボニ ルハライドまたはアラルキルオキシカルボニルハライドの使用量は、化合物 (I) 1モルに対して1モル以上が好ましく、1~10モルの範囲がより好まし い。また、塩基の使用量は、アルコキシカルボニルハライド、アルケニルオキシ カルボニルハライド、アリールオキシカルボニルハライドまたはアラルキルオキ 15 シカルボニルハライド1モルに対して0.1モル以上が好ましく、1~10モル の範囲がより好ましい。さらに、2種類以上の塩基を共存させてもよく、2種類 以上の塩基を共存させる場合の塩基の使用量は、アルコキシカルボニルハライド、 アルケニルオキシカルボニルハライド、アリールオキシカルボニルハライドまた 20 はアラルキルオキシカルボニルハライド1モルに対して少なくとも一つの塩基が 0. 1 モル以上であることが好ましく、一つの塩基が少なくとも 0. 1~10モ ルの範囲であることがより好ましい。

前記したアルコキシアルキル基を水酸基の保護基とする場合、反応は、1-メトキシメチルクロリド、1-メトキシメチルブロミド、ベンジルオキシメチルクロリド、p-エトロベンジルメトロリド、p-エトロベンジルメトキシメチルクロリド、o-ニトロベンジルメトキシメチルクロリド、(4-メトキシフェノキシ)メチルクロリド、tert-ブトキシメチルクロリド、2-メ

トキシエトキシメチルクロリド、2-(トリメチルシリル)エトキシメチルクロ リドなどのアルコキシアルキルハライドを、水素化リチウム、水素化ナトリウム、 水素化カリウム、水素化カルシウムなどの金属水素化物;リチウム、ナトリウム、 カリウムなどのアルカリ金属;マグネシウム、カルシウムなどのアルカリ土類金 属;炭酸ナトリウム、炭酸カリウムなどの炭酸塩;炭酸水素ナトリウム、炭酸水 5 素カリウムなどの炭酸水素塩;トリメチルアミン、トリエチルアミン、ジイソプ ロピルエチルアミン、ピリジン、N, Nージメチルアミノピリジン、N, Nージ メチルアニリン、N、Nージエチルアニリンなどのアミンなどの塩基の存在下に、 化合物(I)と反応させることにより行うことができる。アルコキシアルキルハ ライドの使用量は、化合物 (I) 1モルに対して1モル以上が好ましく、1~1 10 0 モルの範囲がより好ましい。塩基の使用量は、アルコキシアルキルハライド1 モルに対して0、1モル以上が好ましく、1~10モルの範囲がより好ましい。 さらに、2種類以上の塩基を共存させてもよく、2種類以上の塩基を共存させる 場合の塩基の使用量は、アルコキシアルキルハライド1モルに対して少なくとも 一つの塩基が 0.1 モル以上であることが好ましく、一つの塩基が少なくとも 0. 15 1~10モルの範囲であることがより好ましい。

水酸基の保護基として、前記した三置換シリル基を用いる場合、反応は、トリメチルシリルクロリド、トリメチルシリルブロミド、エチルジメチルシリルクロリド、イソプロピルジメチルシリルクロリド、tertーブチルジメチルシリルクロリド、トリエチルシリルクロリド、tertーブチルジフェニルシリルクロリド、トリフェニルシリルクロリドなどの三置換シリルハライド;トリメチルシリルトリフルオロメタンスルホネート、エチルジメチルシリルトリフルオロメタンスルホネート、イソプロピルジメチルシリルトリフルオロメタンスルホネート、tertーブチルジメチルシリルトリフルオロメタンスルホネート、トリエチルシリルトリフルオロメタンスルホネート、tertーブチルジフェニルシリルトリフルオロメタンスルホネート、トリフェニルシリルトリフルオロメタンスルホネート、トリフェニルシリルトリフルオロメタンスルホネート、トリフェニルシリルトリフルオロメタンスルホネートなどの三置換シリルトリフルオロメタンスルホネートなどの三置換シリルトリフルオロメタンスルホネート

20

を、水素化ナトリウム、水素化カリウムなどの金属水素化物;炭酸ナトリウム、 炭酸カリウムなどの炭酸塩;炭酸水素ナトリウム、炭酸水素カリウムなどの炭酸 水素塩;トリエチルアミン、ジエチルアミノピリジン、イミダゾール、2,6-ルチジンなどのアミンなどの塩基の存在下に、化合物(I)と反応させることに より行うことができる。三置換シリルハライドまたは三置換シリルトリフルオ 5 ロメタンスルホネートの使用量は、化合物 (I) 1 モルに対して1 モル以上が好 ましく、1~10モルの範囲がより好ましい。また、塩基の使用量は、三置換シ リルハライドまたは三置換シリル トリフルオロメタンスルホネート1モルに対 して0.1 モル以上が好ましく、 $0.1 \sim 10$ モルの範囲がより好ましい。さら に、2種類以上の塩基を共存させてもよく、2種類以上の塩基を共存させる場合 10 の塩基の使用量は、三置換シリルハライドまたは三置換シリル トリフルオロメ タンスルホネート1モルに対して少なくとも一つの塩基が0.1モル以上である ことが好ましく、一つの塩基が少なくとも0.1~10モルの範囲であることが より好ましい。

15 化合物(I)の水酸基を保護する反応は、溶媒の存在下または不存在下で行うことができる。使用できる溶媒としては、反応に悪影響を与えない限り特に制限はなく、例えばジクロロメタン、ジクロロエタン、クロロベンゼン、ジクロロベンゼンなどのハロゲン化炭化水素;テトラヒドロフラン、ジエチルエーテル、ジメトキシエタンなどのエーテル;ペンタン、ヘキサン、ヘプタン、オクタン、石20 油エーテル、ベンゼン、トルエンなどの炭化水素;N,NージメチルホルムアミドなどのNーアルキル置換アミドまたはこれらの混合物などが挙げられる。溶媒を用いる場合、その使用量に特に制限はないが、通常、化合物(I)に対して1~100重量倍の範囲が好ましい。

反応温度は、-80℃~200℃の範囲が好ましく、-20℃~180℃の範 25 囲がより好ましい。また、反応時間は、通常0.1~100時間、好ましくは1 ~24時間である。

このようにして得られたプレグナン誘導体(II)は、通常の有機化合物の単

離・精製に用いられる方法により単離・精製することができる。例えば、反応混合物を食塩水または水にあけ、ジエチルエーテル、酢酸エチル、塩化メチレンなどの有機溶媒で抽出する。抽出液を、必要に応じて飽和炭酸水素ナトリウム水溶液などで洗浄して酸性物質を除去し、希塩酸、水、食塩水などで洗浄して塩基性物質、水溶性物質を除去した後、無水硫酸マグネシウム、無水硫酸ナトリウムなどで乾燥し、濃縮して得られる粗生成物を必要に応じて蒸留、クロマトグラフィー、再結晶などにより精製する。

5

20

10 すなわち (5α, 7α, 20S) -21- (((1, 1-ジメチルエチル) ジメ チルシリル) オキシ) -20-メチルプレグナー3-オンー7-オール ベンゾ エートは、新規化合物であり、しかも工業的に容易に実施可能な再結晶により精 製することができるものである。

 工程2:プレグナン誘導体(II)の21位シリルオキシ基のシリル基を脱保護

 15
 させて21ーヒドロキシプレグナン誘導体(III)を得る工程

プレグナン誘導体(II)の21位シリルオキシ基のシリル基を脱保護させて21-ヒドロキシプレグナン誘導体(III)を得る反応は、通常知られているシリルオキシ基のシリル基を脱保護させる方法を使用できる[プロテクティブ・グループス・イン・オルガニック・シンセシス(Protective Groups in Organic Synthesis)第3版、114頁(199年)、ジョン・ワイリー&サンズ出版(John Wiley & Sons, Inc.)など参照]。

反応に際しては、反応系に少なくとも塩類または酸を共存させることが特に好ましい。かかる塩類としては、例えば、テトラメチルアンモニウムフルオリド、

25 テトラエチルアンモニウムフルオリド、テトラプロピルアンモニウムフルオリド、 テトラブチルアンモニウムフルオリドなどの含フッ素アンモニウム塩類;フッ化 リチウム、フッ化ナトリウム、フッ化カリウム、フッ化セシウムなどの含フッ素

PCT/JP02/11547 WO 03/051904

アルカリ金属塩類;フッ化カルシウムなどの含フッ素アルカリ土類金属塩類など が挙げられる。また、酸としては、例えば、メタンスルホン酸、エタンスルホン 酸、プロパンスルホン酸、ベンゼンスルホン酸、p-トルエンスルホン酸などの ・ スルホン酸;フッ化水素酸、塩酸、硫酸などの鉱酸;トリフルオロホウ素、トリ フルオロホウ素ジエチルエーテル錯体などのルイス酸;酢酸;トリフルオロ酢酸、 モノクロロ酢酸、ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸などの含ハロゲン酢酸類などが 挙げられる。

5

25

塩類を共存させる場合、その使用量に特に制限はないが、通常、プレグナン誘 導体(II)1モルに対して1モル以上が好ましぐ、1~10モルの範囲がより 好ましい。また、酸を共存させる場合、その使用量に特に制限はないが、通常、 10 プレグナン誘導体(II)1モルに対して0.001モル以上が好ましく、0. 01~1モルの範囲がより好ましい。また、上記の酸、塩類の2種類以上を混合 させて使用してもよい。

反応は、溶媒の存在下または不存在下で行うことができる。使用できる溶媒と 15 しては、反応に悪影響を与えない限り特に制限はないが、好ましくは有機溶媒が、 挙げられ、例えばメタノール、エタノール、nープロパノール、イソプロパノー ル、n ーブタノール、ベンジルアルコールなどのアルコール; テトラヒドロフラ ン、ジエチルエーテル、ジメトキシエタンなどのエーテル;トルエン、ペンタン、 ヘキサン、ヘプタン、オクタン、石油エーテルなどの炭化水素;ジクロロメタン、 クロロホルム、四塩化炭素、ジクロロエタン、テトラクロロエタン、クロロベン 20 ゼン、oージクロロベンゼンなどのハロゲン化炭化水素またはこれらの混合物な どが挙げられる。溶媒を使用する場合、その使用量に特に制限はないが、通常、 プレグナン誘導体(II)に対して1~200重量倍の範囲が好ましい。

また反応は、反応に悪影響を与えない限り水の存在下または不存在下で行うこ ともできる。水が存在する場合、その存在量に特に制限はないが、通常、プレグ ナン誘導体(II)に対して0.001~200重量倍の範囲が好ましい。さら に上記溶媒中に含有する水、また上記の酸、塩類またはこれら混合物に含有する

水の存在下または不存在下で反応を行ってもよく、含有される水の重量は通常、 プレグナン誘導体(II)に対して0.001~200重量倍の範囲が好ましい。

反応温度は、-100 \mathbb{C} \sim 200 \mathbb{C} の範囲が好ましく、-30 \mathbb{C} \sim 180 \mathbb{C} の範囲がより好ましい。また、反応時間は、通常0.1 \sim 100 時間、好ましくは 1 \sim 24 時間である。

反応は、プレグナン誘導体(II)、必要に応じて塩類または酸、溶媒を混合し、所定温度で撹拌して行うのが好ましい。

このようにして得られた21ーヒドロキシプレグナン誘導体(III)は、通常の有機化合物の単離・精製に用いられる方法により単離・精製することができる。例えば、反応混合物を食塩水または水にあけ、ジエチルエーテル、酢酸エチル、塩化メチレンなどの有機溶媒で抽出する。抽出液を、必要に応じて飽和炭酸水素ナトリウム水溶液などで洗浄して酸性物質を除去し、希塩酸、水、食塩水などで洗浄して水溶性物質を除去した後、無水硫酸マグネシウム、無水硫酸ナトリウムなどで乾燥し、濃縮して得られる粗生成物を必要に応じて蒸留、クロマトグラフィー、再結晶などにより精製する。

10

15

21ーヒドロキシプレグナン誘導体(III)、例えば(5α , 7α , 20 S)-21ーヒドロキシ-20ーメチルプレグナン-3ーオン-7ーオール ベンゾエートは、3位ケトンを保護することにより(5α , 7α , 20 S)-21ーヒドロキシ-3ー(スピロ-2'ー(1', 3'ージオキソラン))-20ー20 メチルプレグナン-7ーオール ベンゾエートとし、ついで21位水酸基を酸化して(5α , 7α , 20 S)-20ーホルミル-3ー(スピロ-2'ー(1', 3'ージオキソラン))ープレグナン-7ーオール ベンゾエートに誘導される(参考例4~6参照)。この化合物は、ジエチルホスホノ-3ーメチル-2ーブタノンとの反応により(5α , 7α , 20 R, 22 E)-24ーオキソ-3ー(スピロ-2'ー(1', 3'ージオキソラン))ーコレステー7ーオール ベンゾエートに誘導され、さらに、ジャーナル・オブ・オーガニック・ケミストリー(1. Org. Chem.)、63巻、3786 頁(1998年);ジャーナ

ル・オブ・オーガニック・ケミストリー (J. Org. Chem.)、63巻、8599頁 (1998年) に記載された方法 (下記スキーム参照) によりスクアラミンに変換される。

5 ところで、上記工程1の出発原料である21ーシリルオキシプレグナン誘導体 (I)、例えば(5α,7α,20S)-7ーヒドロキシー20ーメチルプレグナー3ーオンー21ーオール (1,1ージメチルエチル)ジメチルシリル エーテルの合成方法は、公知である[バイオオルガニック&メディシナル・ケミストリー(Bioorg.Med.Chem.)、8巻、2059頁(200010年);WO 01/79255参照]。しかしながら、(5α,7α,20S)-7ーヒドロキシー20ーメチルプレグナー3ーオンー21ーオール (1,1ージメチルエチル)ジメチルシリル エーテルが再結晶法により精製可能であることは知られていない。

また、化合物(I)の7位水酸基をベンゾイル基で保護した化合物(II-15 1)、すなわち(5α , 7α , 20S)-21-(((1, 1-ジメチルエチル)ジメチルシリル)オキシ)·-20-メチルプレグナー3-オン-7-オールベンゾエートは、工業的に容易に実施可能な再結晶法により精製することができる。

すなわち、(5α , 7α , 20S)-7-ヒドロキシ-20-メチルプレグナー3-オン-21-オール (1, 1-ジメチルエチル)ジメチルシリル エーテルおよび(5α , 7α , 20S) -21-(((1, 1-ジメチルエチル)ジメチルシリル)オキシ)-20-メチルプレグナー3-オン-1-オン-1-オール ベンゾエート(すなわち、1-シリル-1-20-メチルプレグナン誘導体(1-マン)は結晶性を有するので、これらを製造する工程から得られる粗生成物は、工業的に容易に実施可能な再結晶操作、例えば溶媒存在下、粗生成物を加熱させ溶媒に溶解後冷却することにより溶媒中から目的物を析出させる再結晶法ないしは溶媒中で粗生成物を懸濁洗浄させ夾雑物を溶媒中に溶解させて精製する懸濁洗浄法により精製することができる。

以下、21ーシリルー20-メチルプレグナン誘導体(IV)の結晶化による精製方法(結晶精製法)の一例を説明する。

10

20

21-シリル-20-メチルプレグナン誘導体(IV)の結晶精製は通常溶媒15 中で行うことができる。

溶媒としては、21-シリル-20-メチルプレグナン誘導体(IV)の溶媒への溶解度(以下、単に溶解度と称する)が高温の場合において大きく、低温の場合に小さい溶媒が好ましい。高温の場合としては例えば溶媒の加熱還流下を挙げることができ、低温の場合としては例えば室温以下、あるいは室温以上に溶媒の凝固点がある場合は溶媒の凝固点付近を挙げることができる。なお、本明細書中でいう室温とは $15\sim30$ $\mathbb C$ のことである。高温の場合の溶解度と低温の場合の溶解度の差は、差があるほど好適であるが、少なくとも溶解度が高温の場合の溶解度が低温の場合の溶解度の10 %以上大きいことが望ましい。

また、21-シリル-20-メチルプレグナン誘導体(IV)の溶解度が、低 25 温、例えば室温において溶媒の重量に対して50%以下、望ましくは10%以下 である溶媒が好ましい。

溶媒は、低温での溶解度が小さく、高温での溶解度が高い溶媒であればどのよ

うな溶媒でもよいが、好ましくは有機溶媒が挙げられ、例えば、ペンタン、ヘキサン、シクロヘキサン、ヘプタン、メチルシクロヘキサン、オクタン、イソオクタンなどの脂肪族炭化水素;ベンゼン、トルエン、ローキシレン、エーキシレン、カーキシレンなどの芳香族炭化水素;ジエチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、ジ(ロープロピル)エーテル、ジ(ローブチル)エーテル、テトラヒドロフラン、テトラヒドロピランなどのエーテル;酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸ロープロピル、酢酸イソプロピル、酢酸ローブチルなどのエステルまたはこれらの混合物などが挙げられる。

溶媒の使用量に特に制限はないが、通常、21-シリル-20-メチルプレグ 10 ナン誘導体(IV)に対して0.001~1000重量倍の範囲、好ましくは0. 01~100重量倍の範囲である。

21ーシリルー20ーメチルプレグナン誘導体(IV)の結晶精製において特に好適な溶媒としては、R⁴¹が水素原子を表すとき、エーテル(特にジイソプロピルエーテル);R⁴¹がベンゾイル基を表すとき、脂肪族炭化水素(特にヘキサン)が挙げられる。

15

結晶精製の際の温度としては、-40℃から200℃までが好ましく、特に-20℃から180℃ないしは当該溶媒の大気圧下の沸点の範囲が特に好ましい。 圧力は、大気圧下から減圧下が好ましく、減圧下で行う場合は温度範囲が-40℃から200℃になるような圧力範囲が好ましい。

20 結晶精製の方法は、21ーシリルー20ーメチルプレグナン誘導体(IV)の 粗結晶に上記溶媒を添加するか、上記溶媒に21ーシリルー20ーメチルプレグ ナン誘導体(IV)の粗結晶を加え、撹拌する。必要に応じて加熱し、粗結晶が 溶解したことを確認後、冷却させ、結晶を析出させる。冷却時に必要に応じて種 結晶を結晶析出の助剤として添加してもよい。

25 また、21-シリル-20-メチルプレグナン誘導体(IV)の粗結晶を含む 反応抽出液を大気圧ないしは減圧下に加熱濃縮して粗結晶とする際、上記溶媒を 添加して上記溶媒に濃縮置換し、粗結晶を得ることなく結晶精製を行ってもよく、

溶媒濃縮置換後の冷却時に種結晶を結晶析出の助剤として添加してもよい。

5

10

これら結晶精製において、結晶を析出させる時間あるいは不純物を除去させる時間としては、結晶精製の際の温度において、溶媒に溶解していた目的化合物が析出し、溶媒中に目的化合物が飽和している状態、あるいは目的化合物中に含まれる不純物が十分に溶媒に溶解し、不純物が溶媒中に飽和している状態となるまでの時間であることが望ましく、例えば0.01~100時間の範囲であるのが好ましく、0.1~24時間の範囲であるのがより好ましい。

得られた結晶を含む溶液からの結晶の分離は、濾紙、濾布上に結晶を含む溶液を展開し、濾過することにより行う。必要に応じて上記溶媒で結晶を洗浄してもよく、また溶媒を除去するために乾燥器等で乾燥させてもよい。

以下、実施例により本発明をさらに具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例により何ら限定されるものではない。

参考例1 (7α, 20S) - 7, 21-ジヒドロキシ-20-メチルプレグナ -1, 4-ジエン-3-オンの合成

15 (7α, 20S) -7-ヒドロキシー3-オキソプレグナー1, 4-ジエンー20-カルバルデヒド20.0g(54.8mmol)にエタノール200mlを加え、撹拌しながら氷冷した。この溶液に、水素化ホウ素ナトリウム0.61g(16.1mmol)を数回に分けて加え、添加終了後、氷冷下で1時間撹拌した。反応液に3%塩酸を加えて中和し、さらに水200mlを加えた後、エタノールを減圧下で留去した。残留物中に析出した粗結晶を濾過して回収後、水洗した。得られた粗結晶にトルエンを添加して加熱し、粗結晶中の水をトルエンとの共沸により除去した後、トルエンを減圧下で留去することにより、下記の物性を有する(7α, 20S) -7, 21-ジヒドロキシー20-メチルプレグナー1, 4-ジエンー3-オン18.8g(収率93%)を得た。

 1 H-NMRスペクトル(270MHz、CDCl₃、TMS、ppm) δ : 0. 765 (s, 3H), 1. 048 (d, 3H, J=6.6Hz), 1. 238 (s, 3H), 2. 490 (dd, 1H, J=3.3, 13.9Hz), 2. 7

37 (ddd, 1H, J=1.8, 3.3, 13.9Hz), 3.366 (dd, 1H, J=6.9, 10.2Hz), 3.635 (dd, 1H, J=3.3, 10.2Hz), 4.041 (brs, 1H), 6.143 (m, 1H), 6.253 (dd, 1H, J=1.8, 10.1Hz), 7.072 (d, 1H, J=10.1Hz).

参考例 2 (5 α, 7 α, 2 0 S) - 7, 2 1 - ジヒドロキシー 2 0 - メチルプ レグナー 3 - オンの合成

5

窒素雰囲気下、容量200mlの三口フラスコに液体アンモニア (70ml) を-78℃でため、次いでリチウム金属0.403g(58.1mmo1)を-78℃に保ちながらゆっくり加えた。リチウム金属を完全に溶解させた後、この 10 混合物に参考例1の方法で得られた(7α , 20S)-7, 21-ジヒドロキシ-20-メチルプレグナー1, 4-ジェン-3-オン2. 00g(5.81mm) o 1)をテトラヒドロフラン50m1に懸濁させた溶液をゆっくり滴下し、滴下 終了後、-78℃で2時間撹拌した。反応液に塩化アンモニウム3.73 g (6) 9. 7 mm o 1) を加えた後、反応液を室温まで徐々に昇温しながら12時間撹 15 拌し、アンモニアを除去した。得られた白色の残渣にトルエン50mlおよび 3%塩酸100m1を加えて溶解させ、有機層と水層を分離した。有機層を飽和 食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、濃縮し、得られた粗生成物2. 09gをシリカゲルカラムクロマトグラフィー(展開液:酢酸エチル/ヘキサン =2/1 (容量比)) で精製することにより、下記の物性を有する (5 α , 7 α , $20 \cdot$ 205) -7, 21-ジヒドロキシ-20-メチルプレグナ-3-オン1.32 gを得た(収率65%)。

 $(5\alpha, 7\alpha, 20S) - 7, 21$ -ジヒドロキシー20-メチルプレグナー3-オン

 1 H-NMRスペクトル(270MHz、CDC· 1 3、TMS、ppm) δ : 0. 710 (s, 3H), 1. 007 (s, 3H), 1. 044 (d, 3H, J=6. 9Hz), 1. 0-2. 5 (m, 22H), 3. 339 (dd, 1H, J=6.

9, 10. 9Hz), 3. 614 (dd, 1H, J=3. 0, 10. 9Hz), 3. 84-3. 85 (brs, 1H).

20 · 法)

25

5

参考例3で得られた粗(5α , 7α , 20S)-7-ヒドロキシー20-メチルプレグナー3-オンー21-オール (1, 1-ジメチルエチル)ジメチルシリル エーテル69. 98gにジイソプロピルエーテル140m1を添加し、室温下1時間撹拌した。撹拌後濾過し、得られた結晶をジイソプロピルエーテル169m1で洗浄したのちに減圧乾燥させることにより、下記の物性を有する(5α , 7α , 20S)-7-ヒドロキシー20-メチルプレグナー3-オンー21-オール (1, 1-ジメチルエチル)ジメチルシリル エーテル37. 39g

を得た(参考例3と実施例1を通しての通算収率50%)。

 1 H-NMRスペクトル(270MHz、CDC1 $_{3}$ 、TMS、ppm) $\delta:0.$ 029(s, 6H), 0. 699(s, 3H), 0. 890(s, 9H), 0. 992(d, 3H, J=7. 9Hz), 1. 007(s, 3H), 1. 1-2. 4(m, 22H), 3. 264(dd, 1H, J=7. 9, 9. 9Hz), 3.

5 4 (m, 22H), 3. 264 (dd, 1H, J=7. 9, 9. 9Hz), 3. 570 (dd, 1H, J=3. 0, 9. 9Hz), 3. 874 (bd, 1H, J=1. 7Hz).

融点:211~217℃

実施例2 (5α, 7α, 20S) - 21-(((1, 1-ジメチルエチル) ジ
 メチルシリル) オキシ) - 20-メチルプレグナー3-オン-7-オール・ベン
 ゾエートの合成(プレグナン誘導体(II)を得る工程)

窒素雰囲気下、容量 5 0 0 m 1 のフラスコに実施例 1 の方法で得られた (5 α, 7 α, 2 0 S) - 7 - ヒドロキシー 2 0 - メチルプレグナー 3 - オンー 2 1 - オール (1, 1 - ジメチルエチル) ジメチルシリル エーテル 3 7. 3 9 g (8 0. 8 m m o 1)、4 - ジメチルアミノピリジン 9. 7 g (7 9. 4 m m o 1)、ピリジン 3 2. 6 m 1 (4 0 3 m m o 1)、炭酸カリウム 1 1. 2 g (8 1. 0)

mm o 1) およびトルエン370 m 1 を入れて撹拌しながら氷冷した。この溶液に、ベンゾイルクロリド23.46 m 1 (202 m m o 1) をゆっくり滴下し、滴下終了後、氷冷下で15分間撹拌し、その後、加熱還流させ9時間撹拌した。

20 反応液を水300m1に展開し、有機層と水層を分離し、水層をトルエン300m1で再抽出した。水層分離後、有機層を混合後、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液300m1、水300m1、希塩酸1982m1(35%塩酸33m1と水1949m1より調製)、水300m1で順次洗浄した。水層分離後、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、濾過濃縮することにより、粗(5α,7α,20S)-21

実施例3 (5 α , 7 α , 20S) -21-(((1, 1-ジメチルエチル) ジ

メチルシリル) オキシ) -20-メチルプレグナ-3-オン-7-オール ベン ゾエートの精製(21-シリル-20-メチルプレグナン誘導体(IV)の結晶 精製法)

実施例2で得られた粗(5α , 7α , 20S)-21-(((1, 1-i)メチルエチル)ジメチルシリル)オキシ)-20-メチルプレグナー3-オン-7-オール ベンゾエート55.1gにヘキサン200m1を添加し、65 に加熱し溶解させた。溶解確認後、15分間攪拌し、冷却した。氷冷下15分間撹拌後、濾過し、氷冷下で冷却したヘキサン50m1で2回析出物を洗浄した。析出物を減圧下乾燥させることにより下記物性を有する(5α , 7α , 20S)-21-(((1, 1-i)メチルエチル)ジメチルシリル)オキシ)-20-メチルプレグナー3-オン-7-オール ベンゾエート26.2gを得た(実施例2、3を通しての通算収率57%)。

¹H-NMRスペクトル(270MHz、CDC1₃、クロロホルム基準(7.26ppm)、ppm) δ:-0.005 (s,6H),0.721 (s,3 15 H),0.860 (s,9H),0.985 (d,3H,J=5.9Hz),1.079 (s,3H),1.0-1.8 (m,15H),1.9-2.5 (m,7H),3.171 (dd,1H,J=8.9,9.9Hz),3.543 (dd,1H,J=3.0,9.9Hz),5.184 (bd,1H,J=2.0Hz),7.467 (dd,2H,J=6.9,7.9Hz),7.576 (dd,1H,20 J=6.9,6.9Hz),8.011 (d,2H,J=7.9Hz).融点:166~169℃

50m1の三口フラスコ中で実施例3の方法で得られた(5α , 7α , 20S) -21-(((1,1-ジメチルエチル)ジメチルシリル)オキシ)-20-メチルプレグナ-3-オン-7-オール ベンゾエート1.00g(1.76)

mmo1)をテトラヒドロフラン10m1に溶解させ、ついで9%塩酸0.6m 1を添加し、40℃で7時間撹拌した。反応完結後、反応液を濃縮し、水20m 1、酢酸エチル30m1を加え抽出した。水層を分離し、分離した水層をさらに酢酸エチル20m1で抽出した。有機層を混合し、飽和重曹水10m1で2回洗 5 浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥させた。濾過後、濃縮し、下記物性を有する粗(5α,7α,20S)-21-ヒドロキシー3-オキソー20-メチルプレグナンー7-オール ベンゾエート0.80gを得た。得られた粗生成物にアセトン2m1を添加し、加熱溶解後氷冷した。結晶を濾過し、氷冷したアセトン0.5m1で析出物を洗浄した。析出物を減圧下乾燥させることにより、(5α,7
 α,20S)-21-ヒドロキシー3-オキソー20-メチルプレグナンー7ーオール ベンゾエート0.30gを得た(収率38%)。

¹H-NMRスペクトル(270MHz、CDC1₃、TMS、ppm) δ:0. 729 (3H, s), 1.044 (3H, d, J=5.9Hz), 1.080 (3H, s), 0.9-2.5 (22H, m), 3.341 (1H, dd, J= 15 5.9, 9.9Hz), 3.587 (1H, dd, J=2.0, 9.9Hz), 5.192 (1H, bs), 7.475 (2H, d, J=7.9Hz), 7.5 57 (1H, dd, J=6.9, 7.9Hz), 8.006 (2H, d, J=6.9Hz).

融点:156~161℃

25

20 実施例5 (5α, 7α, 20S) -21-ヒドロキシー3-オキソー20-メ チルプレグナン-7-オール ベンゾエートの合成 (21-ヒドロキシプレグナン誘導体 (III) を得る工程)

50m1の三口フラスコ中で実施例3の方法で得られた(5α , 7α , 20S) -21-(((1,1-ジメチルエチル)ジメチルシリル)オキシ)-20-メチルプレグナー3-オン-7-オール ベンゾエート5.00g(8.82mmo1)をテトラヒドロフラン50m1に溶解させ、ついで18%塩酸1.74m1を添加し、<math>40℃で7時間撹拌した。反応完結後、反応液を濃縮し、酢酸

エチル50m1を加え抽出した。水層を分離し、飽和重曹水30m1で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥させた。濾過後、濃縮し、実施例4と同様に、粗 $(5\alpha, 7\alpha, 20S)-21-$ ヒドロキシ-3-オキソ-20-メチルプレグナン-7-オール ベンゾエート3.99gを得た。得られた粗生成物にアセトン14m1を添加し、加熱溶解後氷冷した。結晶を濾過し、氷冷したアセトン0.5m1で析出物を洗浄した。析出物を減圧下乾燥させることにより、 $(5\alpha, 7\alpha, 20S)-21-$ ヒドロキシ-3-オキソ-20-メチルプレグナン-7-オール ベンゾエート2.60gを得た(収率65%)。

参考例4 (5α, 7α, 20S) - 21-ヒドロキシ-3-(スピロ-2'-10 (1', 3'-ジオキソラン)) - 20-メチルプレグナン-7-オール ベン ゾエートの合成

0g(258mmo1)、pートルエンスルホン酸・1水和物0.49g(2.6mmo1)を添加し、加熱還流下40時間撹拌した。反応完結後、飽和重曹水100m1に反応液を添加し、洗浄した。水層を分離後、有機層を飽和食塩水100m1で洗浄した。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥後、濾過濃縮し、得られた粗生成物16.2gをシリカゲルカラムクロマトグラフィー(展開液:酢酸20 エチル/ヘキサン=1/6)で精製することにより、下記物性を有する(5α,7α,20S)-21ーヒドロキシー3ー(スピロー2'ー(1',3'ージオキソラン))-20ーメチルプレグナンー7ーオール ベンゾエート5.16gを得た(収率28%)。

¹H-NMRスペクトル(270MHz、CDCl₃、TMS、ppm) δ:0. 25 699 (s, 3H), 0.882 (s, 3H), 1.039 (d, 3H, J=6. 9Hz), 1.00-2.10 (m, 22H), 3.328 (dd, 1H, J= 5.9, 9.9Hz), 3.577 (dd, 1H, J=3.0, 9.9Hz),

3. 83-3. 93 (m, 4H), 5. 159 (brd, 1H, J=2. 0Hz), 7. 48 (dd, 2H, J=6. 9Hz), 7. 59 (d, 1H, J=6. 9Hz), 8. 056 (d, 2H, J=6. 9Hz).

参考例 5 (5 α, 7 α, 2 0 S) - 2 1 - ヒドロキシ-3 - (スピロ-2' - (1', 3' - ジオキソラン)) - 2 0 - メチルプレグナン-7 - オール ベン ゾエートの合成

実施例4の方法で得られた(5 α, 7α, 20S)-21-ヒドロキシー3-オキソー20ーメチルプレグナン-7ーオール ベンゾエート3.97g(8.77mmo1)をトルエン49m1に溶解させ、エチレングリコール2.75g (44.3mmo1)、pートルエンスルホン酸・1水和物0.05g(0.3mmo1)を添加し、加熱還流下4時間撹拌した。反応完結後、飽和重曹水10m1に反応液を添加し、洗浄した。水層を分離後、有機層を飽和食塩水10m1で洗浄した。有機層を無水硫酸ナトリウムで乾燥後、濾過濃縮し、得られた粗生成物4.71gをシリカゲルカラムクロマトグラフィー(展開液:酢酸エチル/ヘキサン=1/6)で精製することにより、参考例4と同様に、(5α, 7α, 20S)-21-ヒドロキシー3-(スピロ-2'-(1', 3'-ジオキソラン))-20-メチルプレグナン-7-オール ベンゾエート3.44gを得た(収率79%)。

参考例 6 (5 α, 7 α, 2 0 S) - 2 0 - ホルミル-3 - (スピロ-2'-20 (1', 3'-ジオキソラン)) - プレグナン-7 - オール ベンゾエートの合成

参考例4の方法で得られた(5α, 7α, 20S) - 21-ヒドロキシー3-(スピロ-2'-(1', 3'-ジオキソラン)) - 20-メチルプレグナンー7-オール ベンゾエート21.4g(43mmo1)、2, 2, 6, 6-テトラメチル-1-ピペリジニルオキシ,フリーラジカル0.13g(0.8mmo1)をジクロロメタン214m1に溶解させて氷冷し、この溶液に、臭化カリウム0.51g(4.3mmo1)を水21m1に溶解させて得られた溶液を氷冷

下で添加して、激しく撹拌させた。次いで、この混合液に、次亜塩素酸ナトリウム水溶液(2.64 w t %, 108 m 1, 40 m m o 1) に炭酸水素ナトリウム(1.0 g)を添加した水溶液を氷冷下で滴下し、滴下終了後、氷冷下で2時間反応させた。反応終了後、有機層と水層を分離し、水層をジクロロメタンで抽出した(30 m 1 × 2)。抽出液を有機層と合わせて水(50 m 1 × 2)、飽和食塩水(20 m 1)で順次洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、濃縮し、得られた粗生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(展開液:酢酸エチル/ヘキサン=1/4(容量比))で精製することにより、下記の物性を有する(5 α , 7 α , 20 S) -20 - ホルミル-3 (スピロ-2' - (1', 3' - ジオキソラン)) - プレグナン- 7 - オール ベングエート 16.9 gを得た(収率 79%)。

¹H-NMRスペクトル(270MHz、CDCl₃、TMS、ppm) δ:0.725 (s, 3H), 0.886 (s, 3H), 1.108 (d, 3H, J=6.9Hz), 1.13-1.97 (m, 21H), 2.30-2.38 (m, 1H), 3.830-3.929 (m, 4H), 5.166 (m, 1H), 7.483 (dd, 2H, J=6.9, 6.9Hz), 7.580 (ddd, 1H, J=2.0, 6.9Hz), 9.518 (d, 1H, J=3.0Hz).

産業上の利用可能性

20 本発明によれば、スクアラミンの合成中間体などとして有用なプレグナン誘導体を、入手容易な原料より、短段階で効率よく製造することができる。

本出願は、日本で出願された特願2001-386808号を基礎としており、その内容は本明細書中に全て包含されるものである。

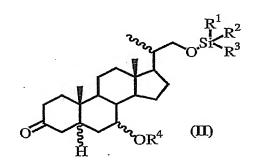
5

請求の範囲

1. 式(I)

(式中、R¹、R²およびR³はそれぞれ独立して置換基を有していてもよいアル キル基、置換基を有していてもよいアルケニル基、置換基を有していてもよいア ルキニル基、置換基を有していてもよいアリール基または置換基を有していても よいアラルキル基を表す。)

で示される21-シリルオキシプレグナン誘導体に、塩基の存在下で、水酸基を 保護することを特徴とする式(II)



(式中、R¹、R²およびR³は前記と同義であり、R⁴は水酸基の保護基を表す。)

で示されるプレグナン誘導体の製造方法。

2. 一般式(II)

$$O = \underbrace{\begin{array}{c} {}^{2} {}^$$

(式中、R¹、R²およびR³はそれぞれ独立して置換基を有していてもよいアルキル基、置換基を有していてもよいアルケニル基、置換基を有していてもよいアルケニル基、置換基を有していてもよいアリール基または置換基を有していてもよいアラルキル基を表し、R⁴は水酸基の保護基を表す。)

で示されるプレグナン誘導体の21位シリルオキシ基のシリル基を脱保護することを特徴とする一般式(III)

(式中、R⁴は前記と同義である。)で示される21ーヒドロキシプレグナン誘 10 導体の製造方法。

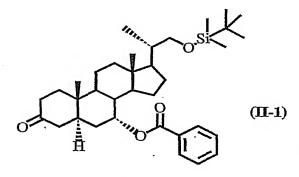
3. 式(IV)

5

(式中、R⁴¹ は水素原子またはベンゾイル基を表す。) で示される21-

(((1, 1-ジメチルエチル) ジメチルシリル) オキシ) - 20-メチルプレ グナン誘導体の精製法であって、該 <math>21-(((1, 1-ジメチルエチル) ジメ チルシリル) オキシ) - 20-メチルプレグナン誘導体を結晶化させることを特 徴とする方法。

5 4. 式(II-1)



で示される $(5\alpha, 7\alpha, 20S) - 21 - (((1, 1 - ジメチルエチル) ジメチルシリル) オキシ) - 20 - メチルプレグナー <math>3$ - オンー 7 - オール ベンゾエート。

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP02/11547

Int.Cl ⁷ C07J5/00, 75/00 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC				
D FIELDS SEADCHED				
B. FIELDS SEARCHED				
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)				
Int.Cl ⁷ C07J5/00, 75/00				
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched				
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)				
CAPLUS, REGISTRY (STN)				
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No.				
X Bioorg. Med. Chem., (2000), 8(8), p.2059-65 1-4				
WO 02/20552 A1 (KURARAY CO., LTD.), 1-4				
14 March, 2002 (14.03.02),				
& JP 2002-201199 A				
*				
Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex.				
* Special categories of cited documents: "A" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to				
considered to be of particular relevance understand the principle or theory underlying the invention				
"E" earlier document but published on or after the international filing "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive				
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is step when the document is taken alone				
special reason (as specified) considered to involve an inventive step when the document is				
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art				
"P" document published prior to the international filing date but later "&" document member of the same patent family than the priority date claimed				
than the priority date claimed Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report				
than the priority date claimed				
than the priority date claimed Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report				
than the priority date claimed Date of the actual completion of the international search 08 January, 2003 (08.01.03) Date of mailing of the international search report 21 January, 2003 (21.01.03) Name and mailing address of the ISA/ Authorized officer				
than the priority date claimed Date of the actual completion of the international search 08 January, 2003 (08.01.03) Date of mailing of the international search report 21 January, 2003 (21.01.03)				

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1998)

国際調査報告

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Int. Cl' C07J5/00, 75/00				
B. 調査を行った分野 調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC)) Int. Cl ⁷ C07J5/00, 75/00				
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの				
国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語) CAPLUS, REGISTRY (STN)				
	ると認められる文献	•		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連すると	こきは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号	
X	Bioorg. Med. Chem., (2000), 8(8), p. 2059-65		1–4	
PX	WO 02/20552 A1 (KURARAY CO., LTD.) 2002.03.14 & 1-4 JP 2002-201199 A			
		•	·	
□ C欄の続きにも文献が列挙されている。 □ パテントファミリーに関する別紙を参照。				
* 引用文献のカテゴリー 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」国際出願目前の出願または特許であるが、国際出願目以後に公表されたもの 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行目若しくば他の特別な理由を確立するために引用する文献(理由を付す) 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 「P」国際出願目前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願		の日の後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの 「&」同一パテントファミリー文献		
国際調査を完了した日 08.01.03		国際調査報告の発送日 21.01.03		
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号		特許庁審査官 (権限のある職員) 4P 9159 富永 保 電話番号 03-3581-1101 内線 3490		